

**AMPLIFICATEUR DE TENSION
A FAIBLE CONSOMMATION**

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTERIEUR

5 L'invention concerne un amplificateur de tension à faible consommation.

L'amplificateur de tension à faible consommation selon l'invention peut être utilisé dans tout domaine de l'Electronique. Selon une application 10 particulièrement avantageuse, l'amplificateur de tension à faible consommation selon l'invention est un amplificateur tension/tension de détecteur de photons X ou gamma.

Le schéma de principe d'un détecteur de 15 photons X ou gamma fonctionnant en comptage de photons est représenté en figure 1. Le détecteur comprend un détecteur élémentaire 1, polarisé par une tension Vpol, qui transforme chaque photon détecté en une impulsion de courant, un amplificateur charge/tension A qui 20 intègre le courant délivré par le détecteur élémentaire pendant la durée de l'impulsion et transforme la charge obtenue en une tension, un amplificateur tension/tension 5 qui amplifie le signal délivré par l'amplificateur charge/tension et limite la bande 25 passante de ce signal afin de réduire le bruit du détecteur, un comparateur 6 qui compare la tension délivrée par l'amplificateur 5 avec une tension de seuil Vth et un compteur 7.

L'amplificateur A est généralement 30 constitué d'un amplificateur opérationnel 2 dont l'entrée inverseuse (-) est reliée au détecteur

élémentaire 1 et dont l'entrée non inverseuse (+) est reliée à la masse du circuit, une résistance 3 et un condensateur 4 étant montés en parallèle entre l'entrée inverseuse (-) et la sortie de l'amplificateur 5 opérationnel 2.

De façon générale, les performances demandées à l'amplificateur tension/tension 5 sont les suivantes :

- être capable de traiter des flux d'impulsions rapides (par exemple, plusieurs millions d'impulsions par seconde) ;
- être faible bruit ;
- consommer peu ;
- avoir une impédance d'entrée élevée (de façon à pouvoir être attaqué par l'amplificateur charge/tension situé en amont dont l'impédance de sortie est élevée) ;
- être réalisable en circuit intégré afin d'être peu encombrant ;
- s'adapter au niveau de la tension de repos de l'amplificateur charge/tension situé en amont, qui peut ne pas être bien établi du fait de variations du courant de repos du détecteur élémentaire ou de dispersions technologiques.

La figure 2 représente un amplificateur tension/tension 5 de l'art connu. L'amplificateur comprend un transistor MOS T (MOS pour « Metal Oxide Semiconductor »), un premier condensateur de capacité Ca ayant une première armature reliée à la grille du transistor T, un deuxième condensateur de capacité Cb monté entre la grille et le drain du transistor T, une

résistance r montée en parallèle du deuxième condensateur de capacité C_b et un générateur de courant i monté entre une tension d'alimentation V_{dd} et le drain du transistor T dont la source est reliée à la masse. L'entrée E de l'amplificateur est constituée par la deuxième armature du premier condensateur de capacité C_a et la sortie S de l'amplificateur par le drain du transistor T . Le gain nominal G de l'amplificateur s'écrit alors :

10
$$G = - C_a / C_b$$

La résistance r permet, d'une part, de stabiliser le potentiel sur la grille du transistor T , et, d'autre part, de régler la fréquence de coupure basse du circuit.

15 Un tel amplificateur présente plusieurs limitations. En particulier, la contre-réaction (r, C_b) conduit la grille du transistor T à apparaître, en alternatif, comme une masse virtuelle pour l'étage situé en amont. La recherche d'un gain élevé, et donc 20 d'une valeur de capacité C_a élevée, conduit alors à charger l'étage situé en amont et, partant, à faire consommer ce dernier de façon importante. La consommation globale de l'amplificateur peut alors devenir importante et atteindre plusieurs dizaines, 25 voire plusieurs centaines, de microwatts.

L'amplificateur selon invention ne présente pas cet inconvénient.

EXPOSE DE L'INVENTION

En effet, l'invention concerne un amplificateur de 30 tension comprenant un premier transistor à effet de champ ayant une grille, un drain et une source, la

borne d'entrée et la borne sortie de l'amplificateur étant formées respectivement par la grille et par le drain du premier transistor à effet de champ.
L'amplificateur de tension comprend :

- 5 - un premier générateur de courant qui charge le drain du premier transistor ;
- un deuxième générateur de courant qui charge la source du premier transistor, la valeur du courant délivré par le deuxième générateur de courant étant sensiblement égale à la valeur du courant délivré par le premier générateur de courant ;
- 10 - un premier condensateur ayant une première borne reliée au drain du premier transistor et une deuxième borne reliée à une première tension de référence ;
- un deuxième condensateur ayant une première borne reliée à la source du premier transistor et une deuxième borne reliée à une deuxième tension de référence ; et
- 15 - un transistor à effet de champ supplémentaire de type opposé au premier transistor à effet de champ, le drain du transistor supplémentaire étant relié au drain du premier transistor à effet de champ, la grille du transistor supplémentaire étant reliée à une tension décalée ou non décalée par rapport à la tension appliquée sur la grille du premier transistor à effet de champ, la source du transistor à effet de champ supplémentaire étant reliée au premier générateur de courant et à une première borne
- 20 - un deuxième condensateur ayant une première borne reliée à la source du deuxième générateur de courant et une deuxième borne reliée à une deuxième tension de référence ;
- un troisième condensateur ayant une première borne reliée au drain du deuxième générateur de courant et une deuxième borne reliée à une troisième tension de référence ;
- 25 - un troisième générateur de courant relié à la grille du deuxième condensateur et à la deuxième tension de référence ;
- un quatrième condensateur ayant une première borne reliée à la grille du troisième générateur de courant et une deuxième borne reliée à une quatrième tension de référence ;
- 30 - un quatrième générateur de courant relié à la grille du quatrième condensateur et à la quatrième tension de référence ;

d'un condensateur supplémentaire dont la deuxième borne est reliée à une tension fixe.

Les première et deuxième tensions de référence peuvent être une même tension, par exemple,
5 la tension de référence du circuit (masse).

Selon une caractéristique supplémentaire de l'invention, l'amplificateur comprend un circuit d'asservissement de la tension de sortie qu'il délivre.

10 Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit d'asservissement est constitué d'une résistance connectée entre le drain du premier transistor et une tension fixe.

15 Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit d'asservissement est constitué d'un circuit de lecture dont l'entrée reçoit la tension de sortie de l'amplificateur et dont la sortie délivre un signal de commande de la grille d'un transistor qui constitue le
20 premier ou le second générateur de courant.

Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, l'amplificateur comprend un filtre passe-bas placé en sortie du circuit de lecture pour filtrer le signal de commande délivré par
25 le circuit de lecture.

Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit de lecture est un suiveur de tension.

30 Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit de lecture est un amplificateur différentiel à deux entrées, la

tension de sortie de l'amplificateur étant appliquée sur une première entrée de l'amplificateur différentiel et une tension de référence étant appliquée sur la deuxième entrée de l'amplificateur différentiel.

5 Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit de lecture est un amplificateur qui amplifie les variations de la tension de sortie de l'amplificateur par rapport à une tension de référence déterminée à partir d'une tension
10 de réglage.

Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit d'asservissement est constitué d'un transistor MOS monté en grille commune et dont la source est connectée
15 à la sortie de l'amplificateur.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, la grille du premier transistor à effet de champ et la grille du transistor supplémentaire sont reliées entre elles.

20 Selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, l'amplificateur comprend un circuit de décalage de tension pour former la tension appliquée sur la grille du transistor supplémentaire à partir de la tension appliquée sur la grille du premier
25 transistor à effet de champ.

Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit de décalage de tension est une source de tension extérieure.

30 Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, le circuit de décalage de tension est une diode polarisée en direct.

Selon encore une caractéristique supplémentaire de l'invention, l'amplificateur est réalisé en technologie MOS.

L'invention concerne également un détecteur 5 de photons X ou gamma comprenant un amplificateur charge/tension et un amplificateur tension/tension qui amplifie la tension délivrée par l'amplificateur charge/tension, caractérisé en ce que l'amplificateur tension/tension est un amplificateur selon l'invention.

10 BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de modes de réalisation préférentiels de l'invention faits en référence aux figures jointes parmi lesquelles :

- 15 - la figure 1 représente un schéma de principe de détecteur de photons X ou gamma selon l'art connu ;
- la figure 2 représente un schéma électrique d'amplificateur tension/tension de détecteur de photons X ou gamma selon l'art connu ;
- 20 - la figure 3 représente un schéma électrique d'amplificateur tension/tension ;
- les figures 4A, 4B, 5A et 5B représentent différentes variantes d'un perfectionnement d'amplificateur tension/tension ;
- 25 - la figure 6 représente un amplificateur tension/tension selon un premier mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 7 représente un amplificateur tension/tension selon un deuxième mode de

réalisation de l'invention ;

- la figure 8 représente un perfectionnement de l'amplificateur tension/tension représenté en figure 6 ;
- 5 - la figure 9 représente un exemple de réalisation d'amplificateur tension/tension selon l'invention.

Sur toutes les figures, les mêmes références désignent les mêmes éléments.

10

DESCRIPTION DETAILLÉE DE MODES DE MISES EN ŒUVRE DE L'INVENTION

La figure 3 représente un schéma électrique d'un amplificateur tension/tension.

15 L'amplificateur tension/tension comprend un transistor MOS M1, un premier générateur de courant I1, un premier condensateur de capacité C1, un deuxième générateur de courant I0 et un deuxième condensateur de capacité C0. Le montage est décrit, à titre d'exemple, 20 avec un transistor MOS de type N. L'homme de l'art peut transposer ce montage sans effort avec un transistor MOS de type P.

L'amplificateur est alimenté entre une tension de polarisation Vdd et une tension de 25 référence, par exemple la masse. La borne d'entrée E et la borne de sortie S de l'amplificateur sont respectivement la grille et le drain du transistor M1.

Le drain du transistor est relié à une première borne du premier générateur de courant I1 dont 30 la deuxième borne est reliée à la tension d'alimentation Vdd. Le premier condensateur de capacité

C1 a une première borne reliée au drain du transistor M1 et une deuxième borne reliée à la masse. La source du transistor M1 est reliée à une première borne du deuxième générateur de courant I0 dont la deuxième 5 borne est reliée à la masse. Le deuxième condensateur de capacité C0 est monté en parallèle du deuxième générateur de courant I0.

Le fonctionnement de l'amplificateur va maintenant être décrit.

10 Au départ, le transistor M1 ne conduit pas. Le générateur de courant I0 injecte des électrons sur la source du transistor M1, lesquels électrons sont stockés dans le condensateur de capacité C0, entraînant la chute du potentiel de source VA, jusqu'à ce que le 15 transistor M1 se mette à conduire. Le potentiel de source VA se stabilise lorsque le courant qui parcourt le transistor M1 devient égal à I0. Tant que le transistor M1 ne conduit pas, la tension de sortie VS de l'amplificateur est égale à la tension 20 d'alimentation Vdd. A partir du moment où le transistor M1 conduit le courant I0, si les courants I1 et I0 sont sensiblement égaux, la borne de sortie S reçoit une somme de courants nulle et la tension de sortie VS peut a priori se stabiliser à une valeur quelconque entre 25 VE-VT et Vdd, où VE est la tension d'entrée de l'amplificateur et VT la tension de seuil du transistor M1.

Supposons la tension de sortie VS égale à une tension de repos VS0. Si l'étage en amont de 30 l'amplificateur module la tension d'entrée VE d'une quantité ΔVE positive, alors le transistor M1 conduit

temporairement davantage et le potentiel VA croît jusqu'à ce que le courant qui parcourt le transistor M1 se stabilise de nouveau à la valeur I0. Il vient alors :

5 $VA \approx VE - VT + \Delta VE.$

La charge Q01 transmise par le transistor M1, de la source vers le drain du transistor M1, pendant la durée Δt_1 du phénomène transitoire décrit ci-dessus s'écrit alors :

10 $Q01 = -I0 \times \Delta t_1 - C0 \times \Delta VE$

Pendant cette même durée Δt_1 , la charge Q1 délivrée par le générateur de courant I1 sur la borne de sortie S s'écrit :

15 $Q1 = I1 \times \Delta t_1, \text{ soit}$

$Q1 \approx I0 \times \Delta t_1$

La variation de charge $\Delta Q1$ sur la borne de sortie S s'écrit alors :

$\Delta Q1 \approx -C0 \times \Delta VE,$

ce qui génère une variation de tension telle que :

20 $\Delta VS \approx - (C0/C1) \times \Delta VE.$

Pendant la durée du transitoire où apparaît la tension ΔVE , l'amplificateur présente ainsi un gain négatif égal à $- (C0/C1)$. Un échelon d'entrée est alors transformé en un échelon de sortie.

25 Lorsque la tension VE revient à son état de repos, et donc varie d'une quantité ΔVE négative, le transistor M1 conduit temporairement moins. La tension VA diminue jusqu'à ce que le courant qui parcourt le transistor se stabilise de nouveau à la valeur I0. La tension VA s'écrit alors :

$$VA \approx VE - VT.$$

La charge Q_{02} transmise par le transistor M1, de la source vers le drain, pendant la durée Δt_2 de ce phénomène transitoire s'écrit alors :

5 $Q_{02} = - I_0 \times \Delta t_2 + C_0 \times \Delta V_E$

Pendant ce même temps Δt_2 , la charge Q_2 délivrée par le générateur de courant I_0 sur la borne de sortie S s'écrit :

$$Q_2 = I_1 \times \Delta t_2, \text{ soit}$$

10 $Q_2 \approx I_0 \times \Delta t_2$

La variation de charge ΔQ_2 sur la borne S s'écrit donc :

$$\Delta Q_2 \approx C_0 \times \Delta V_E$$

ce qui génère une variation de tension ΔV_S telle que :

15 $\Delta V_S \approx (C_0 / C_1) \times \Delta V_E$

Cette variation étant l'opposé de la variation précédente, la tension de sortie V_S revient à sa valeur de repos.

20 L'amplificateur de tension proposé est un amplificateur de tension de gain négatif $-(C_0/C_1)$.

Les principaux avantages d'un tel circuit peuvent être énumérés comme suit :

- l'étage situé en amont de l'amplificateur ne voit comme charge que la faible capacité de grille du transistor M1,
- si la valeur de repos de la tension d'entrée V_E varie, cela change le point d'équilibre de la source du transistor M1 ($VA \approx VE - VT$) et, partant, cela change l'excursion de tension possible pour la tension de sortie V_S (de VA à

Vdd), alors que cela ne change ni la valeur de repos de la tension de sortie VS, ni le gain du montage.

La tension VS disponible en sortie de l'amplificateur est délivrée sous haute impédance. Cela nécessite donc que l'étage aval soit lui-même un étage à haute impédance. Ceci est facilement réalisable à l'aide de circuits intégrés, en particulier de circuits intégrés MOS pour lesquels l'impédance d'entrée de l'étage aval peut être purement capacitive et élevée du fait de la faible taille des transistors (faible capacité de grille). Il faut également noter qu'à la capacité de sortie C1 s'ajoute la capacité parasite de liaison entre l'amplificateur et l'étage aval. Là encore, des circuits intégrés permettent de minimiser les capacités parasites.

Il est souhaitable de réaliser une égalité des courants I₀ et I₁ de façon aussi précise que possible, afin que la tension VS puisse se stabiliser entre la tension V_E - V_T et la tension Vdd. Du fait des dispersions technologiques, une égalité quasi-parfaite entre I₀ et I₁ ne peut généralement pas être obtenue par simple dimensionnement des composants qui constituent le circuit. L'égalité quasi-parfaite entre I₀ et I₁ est alors obtenue à l'aide d'un dispositif d'asservissement.

Les figures 4A, 4B, 5A et 5B représentent différentes variantes d'un perfectionnement d'amplificateur tension/tension.

La figure 4A représente une première variante de ce premier perfectionnement.

Selon cette première variante, l'amplificateur comprend tous les éléments déjà décrits en référence à la figure 3 avec, en plus, une résistance R1. La résistance R1 a une première borne 5 connectée au drain du transistor M1 et une deuxième borne connectée à la tension Vdd. Selon d'autres modes de réalisation, la deuxième borne de la résistance R1 peut être connectée à une tension fixe différente de la tension Vdd, comme par exemple la masse.

10 L'ensemble constitué par la source de courant I1 et la résistance R1 est alors une source de courant non parfaite, de valeur nominale I1, avec une résistance de sortie R1. Par construction, le courant I1 est ici choisi de valeur inférieure à I0. La tension 15 VS se stabilise lorsque la relation suivante est réalisée :

$$\text{Vdd} - \text{VS} = \text{R1} \times (\text{I0} - \text{I1}), \text{ soit}$$
$$\text{VS} = \text{Vdd} - \text{R1} \times (\text{I0} - \text{I1})$$

Dans le cas où la deuxième borne de la 20 résistance R1 est connectée à la masse, par construction le courant I1 est alors choisi supérieur au courant I0. Le courant circulant dans la résistance R1 est alors égal à I1-I0 et les équations qui expriment la tension VS sont modifiées en conséquence.

25 Le circuit selon la première variante du premier perfectionnement ne passe pas les variations très basse fréquence de la tension d'entrée VE. La tension de sortie revient alors vers son point d'équilibre avec la constante de temps R1C1. Ceci est 30 avantageux, car il est généralement demandé à un amplificateur de tension de circuit de détection de

rayons X ou gamma d'être passe-bande (fonction « shaper »).

Si la fréquence de coupure basse est définie par la constante de temps R1C1, la fréquence de coupure haute est, quant à elle, définie par la vitesse de transfert des charges du condensateur de capacité C0 vers le condensateur de capacité C1, c'est-à-dire par la constante de temps $(1/g_m) \times C_0$, où g_m est la transconductance du transistor M1, elle-même définie 10 par le choix du courant I_0 .

L'amplificateur à asservissement représenté en figure 4A régule le courant qui circule dans la résistance R1 de façon que la somme du courant I_1 et du courant qui parcourt la résistance R1 soit égale à I_0 .

La figure 4B représente une deuxième variante du premier perfectionnement.

Selon cette deuxième variante, l'amplificateur comprend tous les éléments déjà décrits en référence à la figure 3 avec, en plus, un transistor MOS TM monté en grille commune et dont la source est connectée à la sortie de l'amplificateur. La grille du transistor TM est alors connectée à une tension fixe V_G telle que :

$$V_G = V_S - V_{Tmos},$$

où V_{Tmos} est la tension de seuil du transistor TM et V_S la tension de sortie de l'amplificateur.

Le transistor TM, fonctionnant en régime saturé, présente alors un comportement fortement non linéaire en fonction de la tension V_S . Un tel montage est 30 particulièrement bien adapté lorsque le signal d'entrée de l'amplificateur est formé d'impulsions.

Le transistor TM peut être de type N ou de type P. Dans le cas où le transistor TM est de type N (figure 4B), son drain est connecté à la tension Vdd et son substrat est à la masse. Le courant I1 est alors 5 inférieur au courant I0 et le montage est adapté à la présence d'impulsions négatives en entrée de l'amplificateur.

Dans le cas où le transistor TM est de type P (non représenté sur les figures), son drain est 10 connecté à la masse et son substrat est connecté à la tension Vdd. Dans ce cas, le courant I1 est supérieur au courant I0 et le montage est adapté à la présence d'impulsions positives en entrée de l'amplificateur.

Deux autres variantes d'amplificateur à 15 asservissement selon le premier perfectionnement sont représentées aux figures 5A et 5B. Seul le circuit représenté en figure 5A sera décrit, le circuit représenté en figure 5B se déduisant à l'évidence du circuit représenté en figure 5A.

Selon le deuxième exemple d'amplificateur 20 tension/tension à asservissement, l'amplificateur comprend tous les éléments déjà décrits en référence à la figure 3 avec, en plus, un circuit de lecture As et un filtre passe-bas constitué d'une résistance R2 en 25 série avec un condensateur de capacité C2.

Le générateur de courant I1 est ici réalisé par un transistor M2a de type P dont le drain, la source et la grille sont reliés, respectivement, au drain du transistor M1, à la tension d'alimentation Vdd 30 et au point intermédiaire entre R2 et C2. L'entrée du circuit As est reliée aux drains des transistors M1 et

M2a (i.e. la sortie S de l'amplificateur). Une première borne du filtre constitué par la résistance R2 en série avec le condensateur de capacité C2 est reliée à la sortie du circuit de lecture As, la deuxième borne du 5 filtre, ou point intermédiaire, étant reliée à la grille du transistor M2a.

La tension de sortie VS est lue par le circuit de lecture As qui reproduit les variations de tension VS avec un gain positif pas nécessairement 10 constant, et avec une tension d'offset pas nécessairement nulle. La sortie du circuit de lecture As est filtrée en basse fréquence par le circuit (R2, C2). La tension filtrée est appliquée à la grille du transistor M2a.

15 La valeur de repos de la tension VS est celle qui produit sur la grille du transistor M2a, via le circuit de lecture As, une tension telle que le courant I1 qui parcourt le transistor M2a soit égal au courant I0.

20 Le circuit de lecture As peut être réalisé de différentes manières. Ainsi, le circuit As peut-il être un suiveur de tension de gain sensiblement égal à l'unité. Le circuit As peut également être un amplificateur différentiel à deux entrées, la tension 25 VS étant appliquée sur une première entrée et une tension de référence étant appliquée sur la deuxième entrée. Dans ce dernier cas, la tension de sortie VS se stabilise à une valeur sensiblement égale à la tension de référence. Un troisième exemple est celui où le 30 circuit As amplifie les variations de la tension VS par rapport à une tension de référence déterminée à partir

d'une tension de réglage, comme cela apparaîtra, à titre d'exemple, à la figure 9.

Afin d'assurer la stabilité du montage, le circuit de lecture As est conçu pour introduire un 5 faible déphasage. L'amplificateur selon les deux variantes décrites aux figures 5A et 5B ne passe pas le continu. La fréquence de coupure basse est définie par la constante de temps R2C2. La fréquence de coupure haute est définie, comme précédemment, par $(1/g_m) \times C_0$.

10 Selon le schéma de la figure 5A, le générateur de courant I0 est maître et le générateur de courant I1 est asservi. La figure 5B représente la variante selon laquelle le générateur de courant I1 est maître et le générateur de courant I0, réalisé à l'aide 15 d'un transistor M2b, est asservi.

La figure 6 représente un amplificateur tension/tension selon un premier mode de réalisation de l'invention. L'amplificateur de l'invention comprend des moyens pour accroître le gain de l'amplificateur.

20 L'amplificateur tension/tension selon l'invention comprend tous les éléments déjà décrits en référence à la figure 3 avec, en plus, un transistor M3 et un condensateur de capacité C01. Le transistor M3 est un transistor MOS de type P monté en série entre le 25 transistor M1 et le générateur de courant I1, le drain, la source et la grille du transistor M3 étant reliés, respectivement, au drain du transistor M1, au générateur de courant I1 et à l'entrée E de l'amplificateur. L'entrée E de l'amplificateur est donc 30 reliée aux grilles des transistors M1 et M3. Le condensateur de capacité C01 a une première borne

reliée à la source du transistor M3 et une deuxième borne reliée à la masse du circuit.

De même que précédemment, l'égalité précise entre les courants I0 et I1 peut être assurée par un dispositif d'asservissement, lequel n'est pas représenté sur la figure 6 afin de ne pas alourdir le dessin. Le dispositif d'asservissement est alors réalisé, par exemple, par l'un quelconque des dispositifs d'asservissement décrits précédemment (cf. figures 4A-5B).

Les transistors M1 et M3 sont en régime saturé. Il s'en suit que :

$$VS > VE - VT(M1), \text{ et}$$

$$VS < VE - VT(M2), \text{ où}$$

VT(M1) est la tension de seuil (positive) du transistor M1 et VT(M2) est la tension de seuil (négative) du transistor M2. C'est le rôle du dispositif d'asservissement (non représenté sur la figure 6) que d'assurer une valeur de repos de la tension VS qui respecte précisément ces deux inéquations.

Lorsque la tension d'entrée VE croît, le courant qui parcourt le transistor M1 croît et le courant qui parcourt le transistor M3 diminue.

A la fin d'un transitoire de tension d'entrée ΔVE , il vient :

$$\Delta VS = -(C_0/C_1+C_{01}/C_1) \times \Delta VE$$

Avantageusement, le gain de l'amplificateur est donc accru. Si, par exemple, les capacités C0 et C01 sont sensiblement égales, le gain est doublé alors que la consommation demeure inchangée.

Un deuxième mode de réalisation de

l'invention est représentée en figure 7. Cette autre mode s'applique préférentiellement au cas où l'étage amont délivre simultanément une tension de sortie sous la forme de deux tensions de repos différentes. Dans le 5 cas où l'étage amont ne délivre qu'une seule tension de sortie, il est clair, pour l'homme de l'art, qu'une duplication de tension peut se réaliser à l'aide d'un étage intermédiaire, par exemple en utilisant la chute de tension qui apparaît aux bornes d'une diode 10 polarisée en direct. Le schéma de la figure 7 illustre, de façon symbolique, la duplication de la tension de sortie de l'étage amont sous la forme d'une tension de décalage V_{dec} appliquée entre la grille du transistor M3 et la grille du transistor M1. La tension V_E est 15 ainsi appliquée sur la grille du transistor M1 et la tension $V_E + V_{dec}$ sur la grille du transistor M3.

Dans le cas où la tension V_{dec} est négative, la valeur minimale nécessaire de la tension d'alimentation V_{dd} est réduite et il est possible, en 20 conséquence, de réduire la puissance dissipée (mais alors l'excursion de la tension VS se trouve également réduite). A l'inverse, dans le cas où la tension V_{dec} est positive, la valeur minimale de la tension d'alimentation V_{dd} est augmentée et il est possible, en 25 conséquence, d'augmenter l'excursion de la tension VS (mais alors la puissance dissipée se trouve également augmentée).

Il faut ici noter que les figures 4A, 4B, 30 5A, 5B décrites précédemment représentent des perfectionnements relatifs à des amplificateurs de tension de l'art connu et que ces perfectionnements,

qui consistent à associer un circuit d'asservissement aux amplificateurs de tension, concernent également l'invention et donc les circuits représentés aux figures 6 et 7. C'est pour des raisons de commodité que 5 les amplificateurs de tension de l'invention munis de circuit d'asservissement n'ont pas été représentés sur des figures.

La figure 8 représente une variante du mode de réalisation représenté en figure 6.

10 En plus des éléments représentés en figure 6, le circuit de la figure 8 comprend un montage cascode constitué de deux transistors MK1 et MK2, respectivement de type P et N, montés en série entre les transistors M3 et M1. La source du transistor MK1 15 est reliée au drain du transistor M3 et la source du transistor MK2 est reliée au drain du transistor M1. Les drains des transistors MK1 et MK2 sont reliés entre eux et constituent la sortie de l'amplificateur de tension. Les tensions VK1 et VK2 respectivement 20 appliquées sur la grille du transistor MK1 et sur la grille du transistor MK2 sont ajustées pour assurer la polarisation en mode cascode. Un avantage du circuit représenté en figure 8 est de réduire les capacités Miller du montage et, en conséquence, de réduire la 25 charge vue par l'étage situé en amont.

Le circuit représenté en figure 8 comprend, à titre d'exemple, un montage cascode à deux transistors. L'invention concerne également des circuits dont le montage cascode ne comprend, par 30 exemple, qu'un seul transistor.

La figure 9 représente un circuit

électrique en technologie MOS illustrant un exemple de réalisation d'amplificateur selon l'invention. Le circuit électrique de la figure 9 correspond à un amplificateur dont le schéma de principe est celui de 5 la figure 7 et qui comprend un dispositif d'asservissement tel que représenté en figure 5B. Il s'en suit que le circuit électrique illustré en figure 9 comprend les générateurs de courant I1 et I0, les transistors M1 et M3, les condensateurs de capacités 10 respectives C0, C1, C01, C2, l'amplificateur de lecture As et la résistance R2, tous ces composants étant réalisés à l'aide de transistors MOS. Le circuit représenté en figure 9 comprend également un circuit de polarisation P de la grille du transistor qui constitue 15 le générateur de courant I1. Le circuit de polarisation P est alimenté par une tension Vddimage qui est également la tension d'alimentation de l'amplificateur de lecture As. L'amplificateur de lecture As est conforme au troisième exemple d'amplificateur de 20 lecture mentionné précédemment et, en conséquence, amplifie les variations de la tension de sortie VS par rapport à une tension de référence déterminée à partir d'une tension de réglage Vr.

Le circuit électrique représenté en figure 25 9 est conçu pour amplifier, avec un gain négatif, des impulsions de tension positives qui sont appliquées sur l'entrée E par rapport à un niveau de repos de la tension d'entrée.

Le montage est polarisé entre une tension 30 Vdd et la masse.

REVENDICATIONS

1. Amplificateur de tension comprenant un premier transistor à effet de champ (M1) ayant une grille, un drain et une source, la borne d'entrée et la borne sortie de l'amplificateur étant formées respectivement par la grille et par le drain du premier transistor à effet de champ, l'amplificateur de tension comprenant :

- un premier générateur de courant (I1) qui charge le drain du premier transistor (M1) ;
- un deuxième générateur de courant (I0) qui charge la source du premier transistor (M1), la valeur du courant délivré par le deuxième générateur de courant (I0) étant sensiblement égale à la valeur du courant délivré par le premier générateur de courant (I1) ;
- un premier condensateur (C1) ayant une première borne reliée au drain du premier transistor (M1) et une deuxième borne reliée à une première tension de référence ; et
- un deuxième condensateur (C0) ayant une première borne reliée à la source du premier transistor (M1) et une deuxième borne reliée à une deuxième tension de référence,

caractérisé en ce qu'il comprend un transistor à effet de champ supplémentaire (M3) de type opposé au premier transistor à effet de champ (M1), le drain du transistor supplémentaire (M3) étant relié au drain du premier transistor à effet de champ (M1), la grille du transistor supplémentaire (M3) étant reliée à une

tension décalée ou non décalée par rapport à la tension appliquée sur la grille du premier transistor à effet de champ (M1), la source du transistor à effet de champ supplémentaire étant reliée au premier générateur de courant (I1) et à une première borne d'un condensateur supplémentaire (C01) dont la deuxième borne est reliée à une tension fixe.

2. Amplificateur selon la revendication 1,
10 caractérisé en ce que, lorsque la grille du transistor supplémentaire est reliée à une tension décalée par rapport à la tension appliquée sur la grille du premier transistor à effet de champ (M1), il comprend un circuit de décalage de tension pour former la tension appliquée sur la grille du transistor supplémentaire (M3) à partir de la tension appliquée sur la grille du premier transistor à effet de champ (M1).

3. Amplificateur selon la revendication 2,
20 caractérisé en ce que le circuit de décalage de tension est une source de tension extérieure.

4. Amplificateur selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le circuit de décalage de tension
25 est une diode polarisée en direct.

5. Amplificateur selon la revendication 1,
caractérisé en ce que, lorsque la grille du transistor supplémentaire est reliée à une tension non décalée par
30 rapport à la tension appliquée sur la grille du premier transistor à effet de champ (M1), la grille du

transistor supplémentaire et la grille du premier transistor à effet de champ sont reliées entre elles.

6. Amplificateur selon l'une quelconque des 5 revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un circuit d'asservissement de la tension de sortie qu'il délivre.

7. Amplificateur selon la revendication 6, 10 caractérisé en ce que le circuit d'asservissement est constitué d'une résistance (R1) connectée entre le drain du premier transistor (M1) et une tension fixe.

8. Amplificateur selon la revendication 6, 15 caractérisé en ce que le circuit d'asservissement est constitué d'un circuit de lecture (As) dont l'entrée reçoit la tension de sortie (VS) de l'amplificateur et dont la sortie délivre un signal de commande de la grille d'un transistor (M2a, M2b) qui constitue le 20 premier ou le second générateur de courant.

9. Amplificateur selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend un filtre passe-bas (R2, C2) placé en sortie du circuit de lecture pour 25 filtrer le signal de commande délivré par le circuit de lecture (As).

10. Amplificateur selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que le circuit de lecture (As) 30 est un suiveur de tension.

11. Amplificateur selon la revendication 8 ou 9, caractérisé en ce que le circuit de lecture (As) est un amplificateur différentiel à deux entrées, la tension de sortie de l'amplificateur étant appliquée 5 sur une première entrée de l'amplificateur différentiel et une tension de référence étant appliquée sur la deuxième entrée de l'amplificateur différentiel.

12. Amplificateur selon la revendication 8
10 ou 9, caractérisé en ce que le circuit de lecture (As) est un amplificateur qui amplifie les variations de la tension de sortie (VS) de l'amplificateur par rapport à une tension de référence déterminée à partir d'une tension de réglage (Vr).

15

13. Amplificateur selon la revendication 6, caractérisé en ce que le circuit d'asservissement est constitué d'un transistor MOS monté en grille commune (TM) et dont la source est connectée à la sortie de 20 l'amplificateur.

25

14. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est réalisé en technologie MOS.

15. Détecteur de photons X ou gamma comprenant un amplificateur charge/tension et un amplificateur tension/tension qui amplifie la tension délivrée par l'amplificateur charge/tension, 30 caractérisé en ce que l'amplificateur tension/tension

est un amplificateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 14.

1 / 6

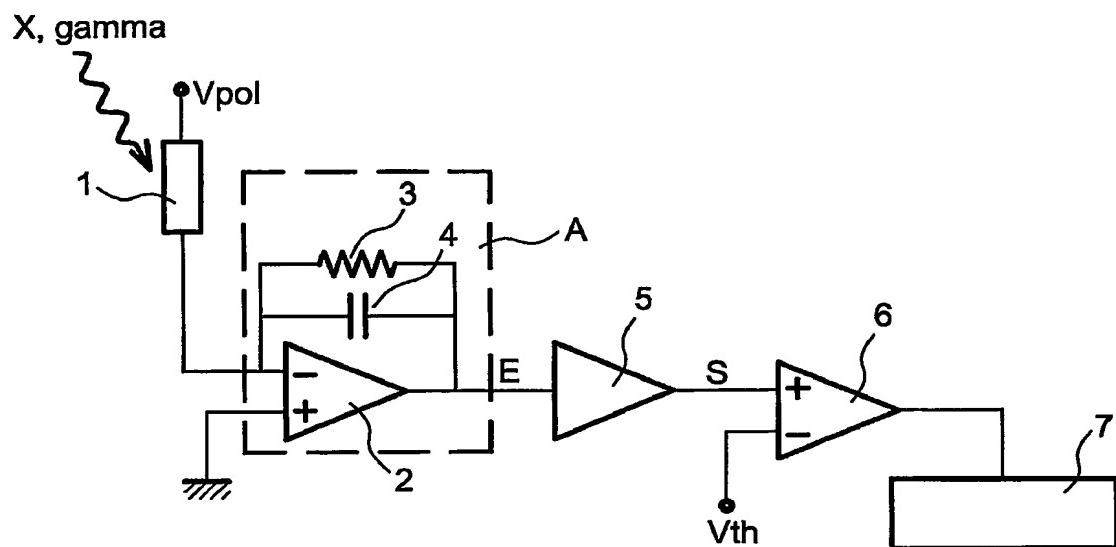


FIG. 1

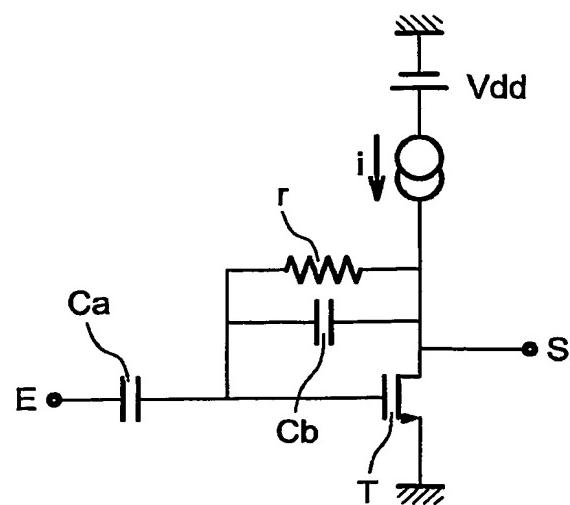


FIG. 2

216

FIG. 3

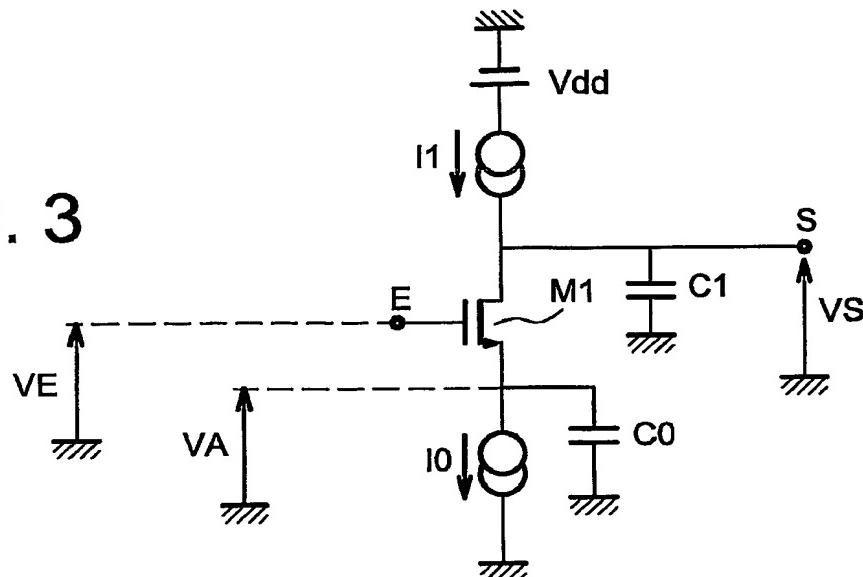
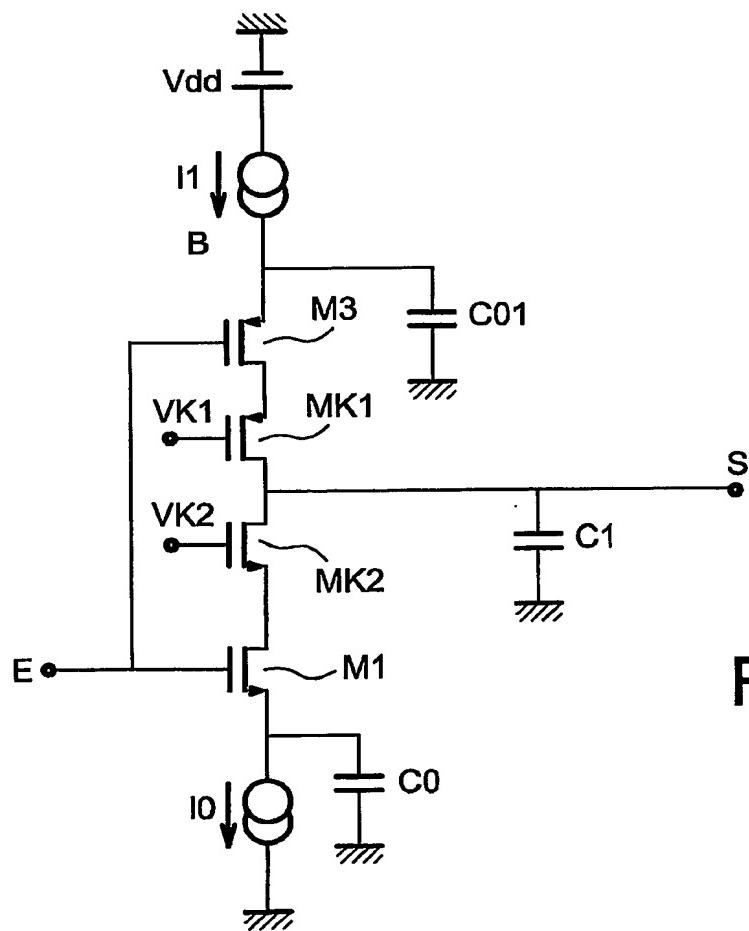


FIG. 8



3 / 6

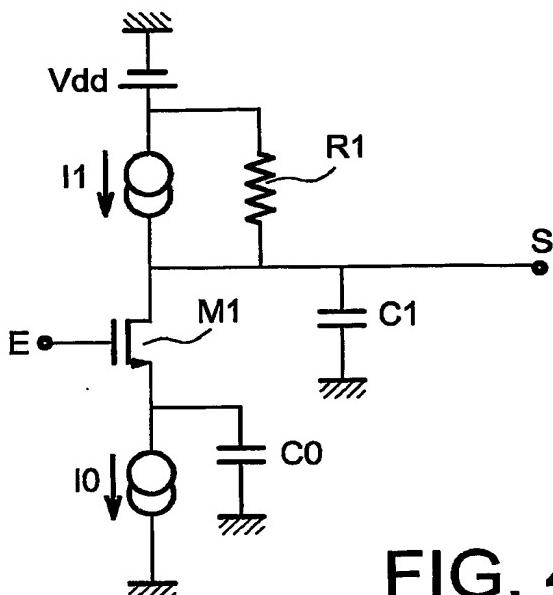


FIG. 4A

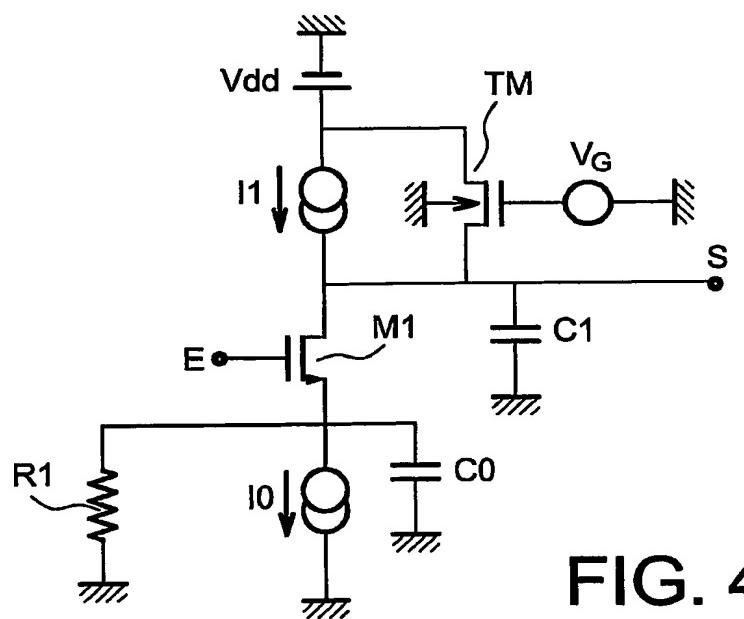


FIG. 4B

4 / 6

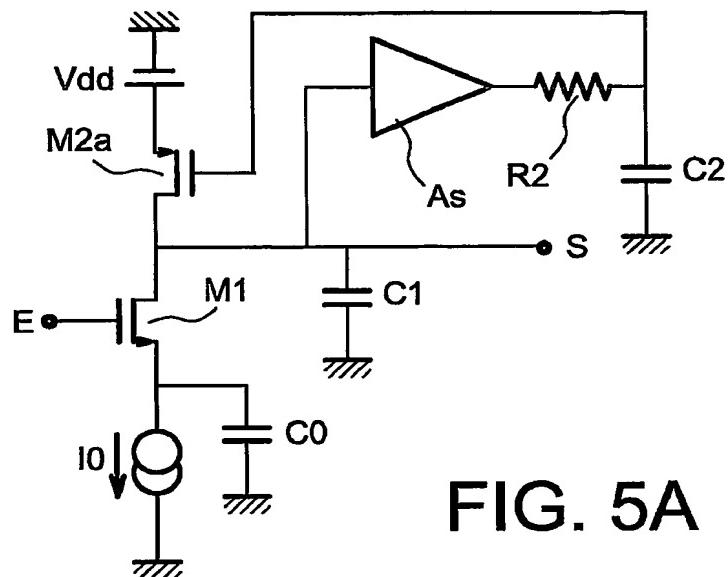


FIG. 5A

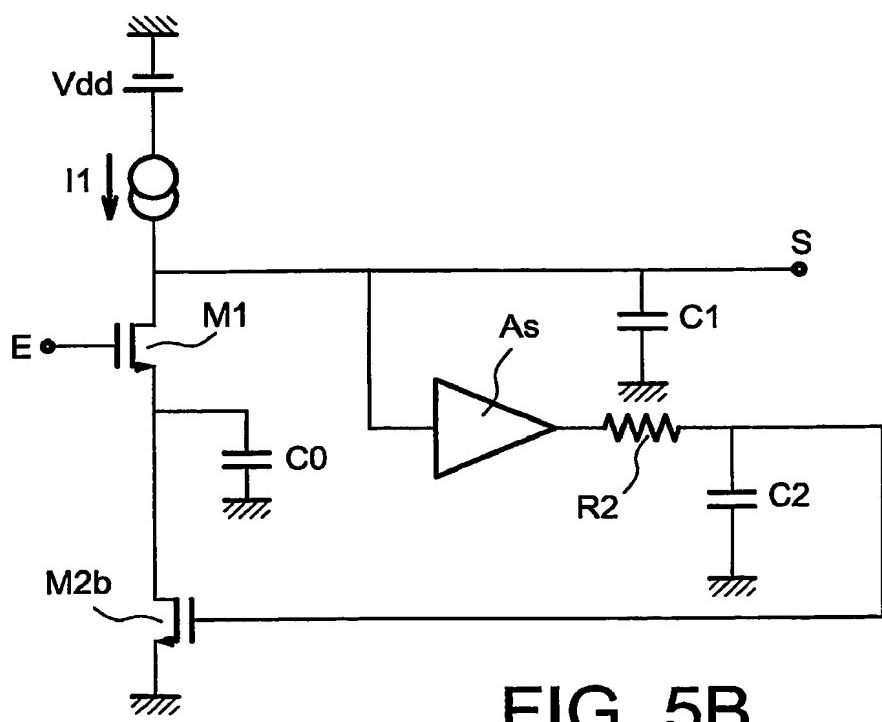


FIG. 5B

5 / 6

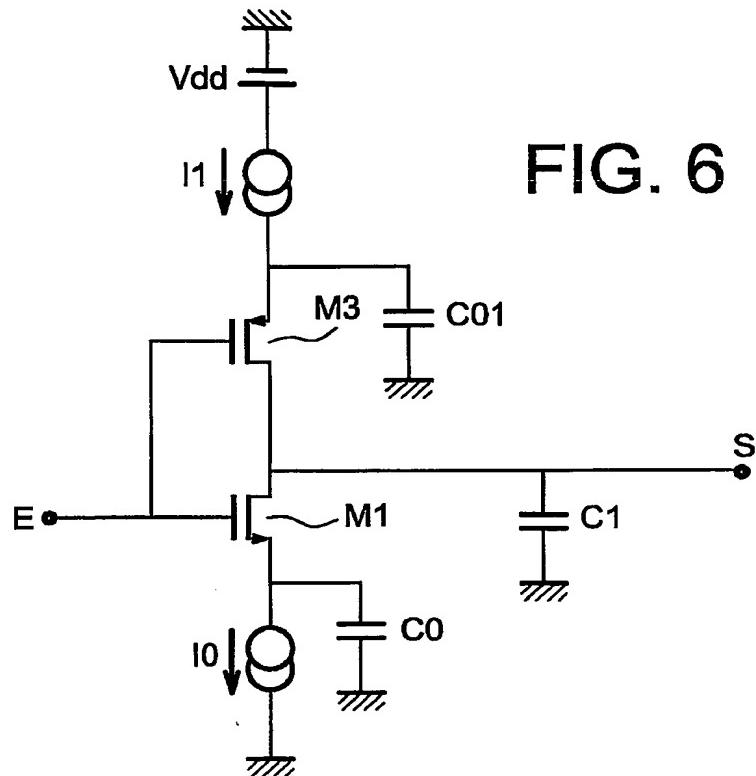


FIG. 6

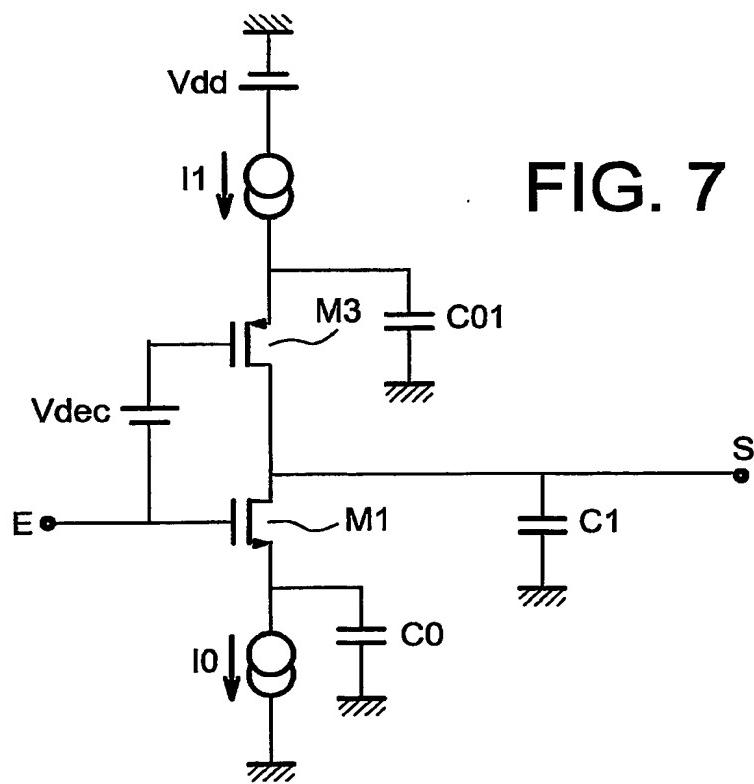


FIG. 7

6 / 6

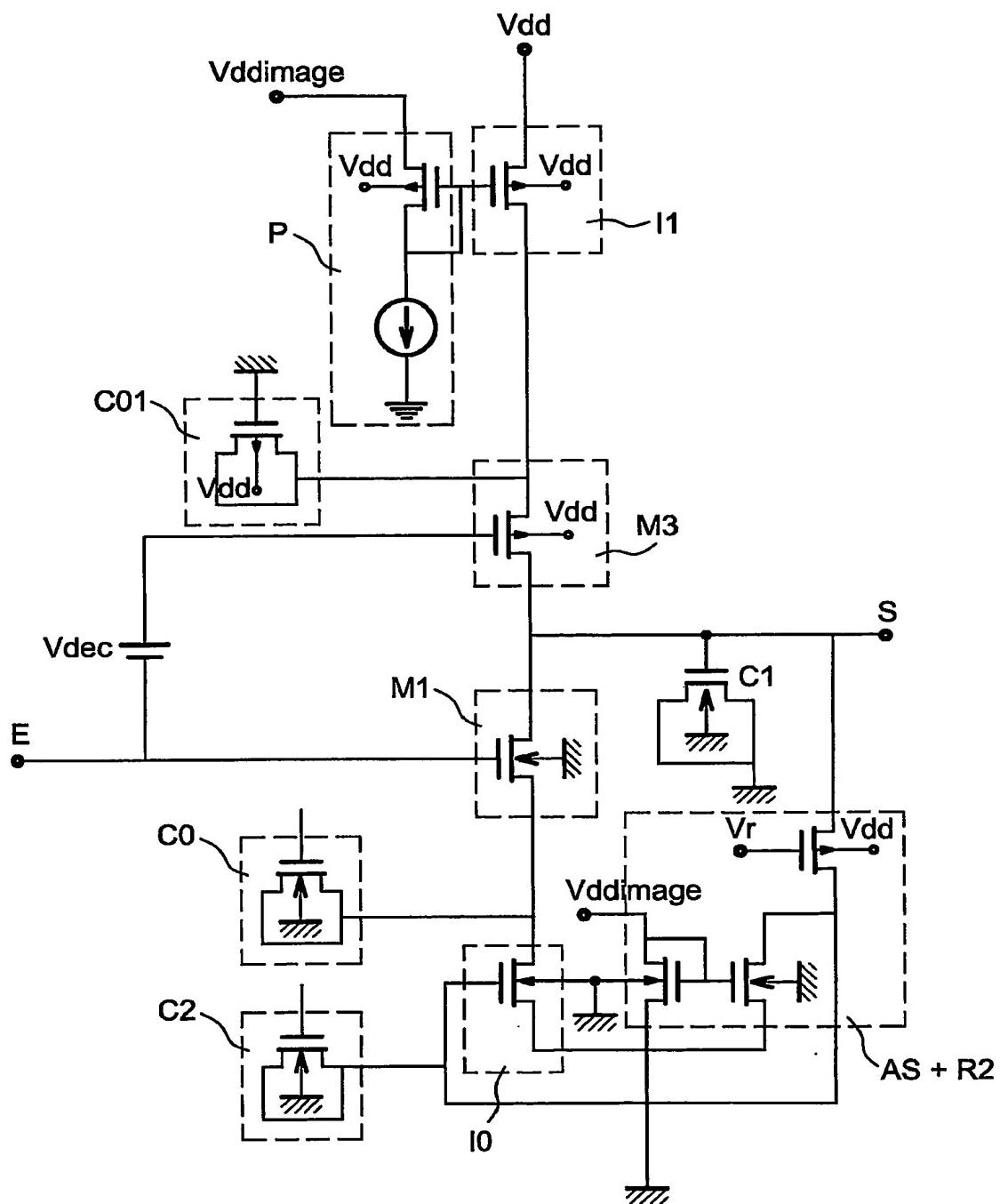


FIG. 9